

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-002740

(43)Date of publication of application : 08.01.2004

(51)Int.Cl.

C08G 65/40
C07C215/82
C08G 85/00
C09K 11/06
H05B 33/14
H05B 33/22

(21)Application number : 2003-080597

(71)Applicant : MITSUBISHI CHEMICALS CORP

(22)Date of filing : 24.03.2003

(72)Inventor : IIDA KOUICHIRO
OGATA TOMOYUKI
SATO YOSHIHARU

(30)Priority

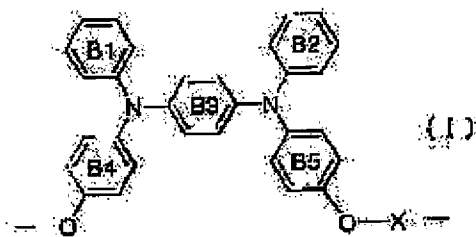
Priority number : 2002081183 Priority date : 22.03.2002 Priority country : JP

(54) POLYMER COMPOUND, 1,4-PHENYLENEDIAMINE DERIVATIVE, CHARGE-TRANSPORTING MATERIAL, ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT MATERIAL AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element drivable at a low voltage and in high luminous efficiency, having good heat resistance and capable of keeping stable luminous characteristics over a long period, in which defect causing short circuit in preparation of element result from surface roughness of an anode is prevented.

SOLUTION: In the organic electroluminescent element, a hole-injecting layer 3 containing a polymer compound having a recurring unit represented by formula (I) and an electron-accepting compound is provided.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 26.09.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection].

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-2740

(P2004-2740A)

(43) 公開日 平成16年1月8日 (2004.1.8)

(51) Int. Cl. ⁷

C08G 65/40

C07C 215/82

C08G 85/00

C09K 11/06

H05B 33/14

F I

C08G 65/40

C07C 215/82

C08G 85/00

C09K 11/06 680

C09K 11/06 690

テーマコード (参考)

3K007

4H006

4J005

4J031

審査請求 未請求 請求項の数 12 O L (全 31 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2003-80597 (P2003-80597)
 (22) 出願日 平成15年3月24日 (2003.3.24)
 (31) 優先権主張番号 特願2002-81183 (P2002-81183)
 (32) 優先日 平成14年3月22日 (2002.3.22)
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(71) 出願人 000005968
 三菱化学株式会社
 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
 (74) 代理人 100086911
 弁理士 重野 剛
 (72) 発明者 飯田 宏一朗
 神奈川県横浜市青葉区鶴志田町1000番
 地 三菱化学株式会社内
 (72) 発明者 緒方 朋行
 神奈川県横浜市青葉区鶴志田町1000番
 地 三菱化学株式会社内
 (72) 発明者 佐藤 佳晴
 神奈川県横浜市青葉区鶴志田町1000番
 地 三菱化学株式会社内
 Fターム (参考) 3K007 AB03 AB06 AB14 DB03 FA01
 最終頁に続く

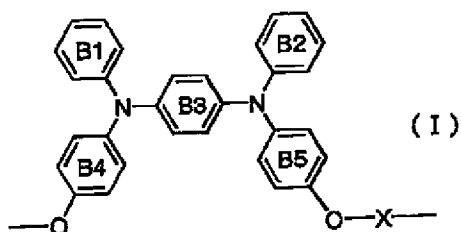
(54) 【発明の名称】 高分子化合物、1, 4-フェニレンジアミン誘導体、電荷輸送材料、有機電界発光素子材料および有機電界発光素子

(57) 【要約】

【課題】 低電圧、高発光効率で駆動させることができ、かつ良好な耐熱性を有し、長期間にわたって安定な発光特性を維持することができる有機電界発光素子であって、陽極の表面粗さに起因する素子作製時の短絡欠陥を防止した有機電界発光素子を提供する。

【解決手段】 下記一般式 (I) で表される繰り返し単位を有する高分子化合物。この高分子化合物と電子受容性化合物とを含有する正孔注入層3を設けた有機電界発光素子。

【化24】



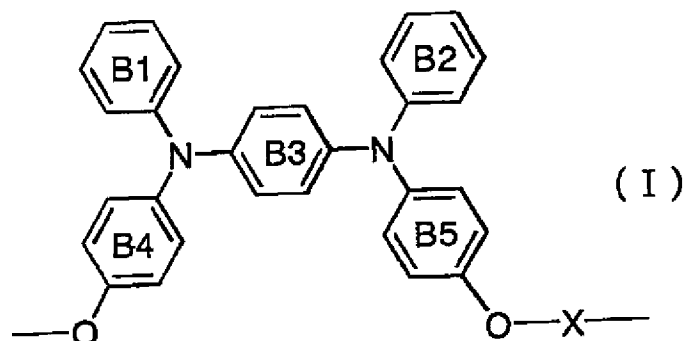
【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記一般式 (I) で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする高分子化合物。

【化 1】



(式中、環 B 1、環 B 2、環 B 4 および環 B 5 は各々独立してベンゼン環を表し、このベンゼン環は、置換基を有していてもよいアシル基、および置換基を有していてもよいアルコキシカルボニル基よりなる群から選ばれる 1 種または 2 種以上の置換基で置換されていてもよい。

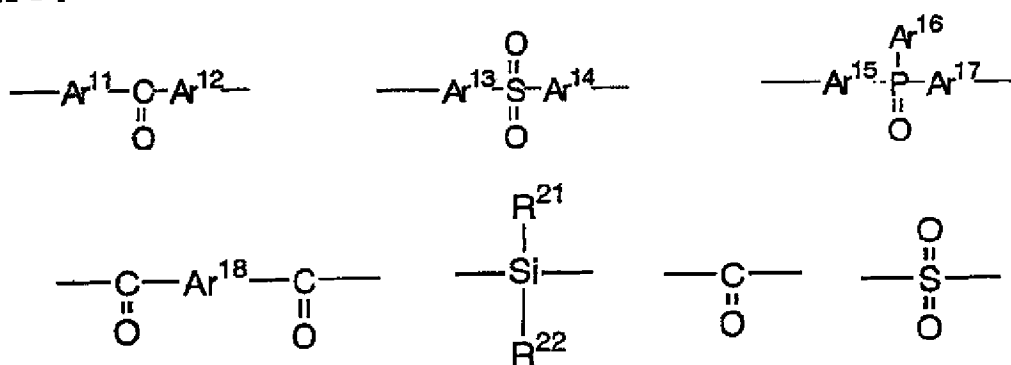
環 B 3 は、置換基を有していてもよいアシル基で置換されていてもよいベンゼン環を表す。

X は、2 価の連結基を表す。)

【請求項 2】

請求項 1 において、一般式 (I) における X が、下記構造式で表される部分構造から選ばれた 2 価の連結基であることを特徴とする高分子化合物。

【化 2】



(式中、 Ar^{11} ないし Ar^{18} は各々独立して、置換基を有していてもよい芳香族環を表し、

R^{21} および R^{22} は各々独立して、水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルケニル基、置換基を有していてもよいアルキニル基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基、置換基を有していてもよいアミノ基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基、または、置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表す。)

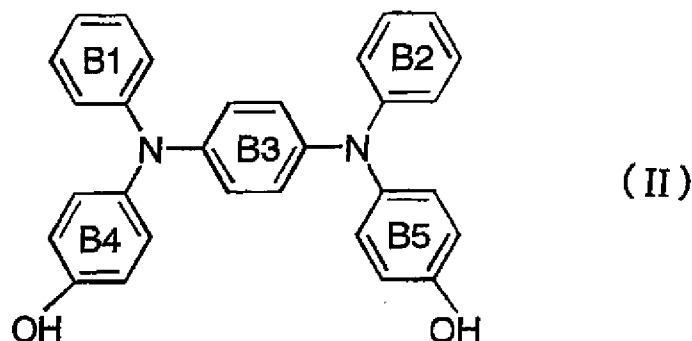
【請求項 3】

請求項 1 または 2 において、重量平均分子量が 1,000 ~ 1,000,000 であることを特徴とする高分子化合物。

【請求項 4】

請求項 1 ないし 3 のいずれか 1 項において、下記一般式 (II) で表される単量体を用いて合成されることを特徴とする高分子化合物。

【化 3】



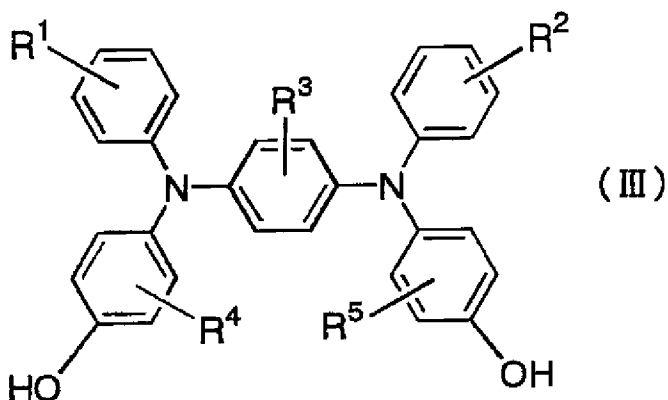
10

(式中、環 B 1 ないし環 B 5 は、前記式 (I) におけると同義である。)

【請求項 5】

下記一般式 (III) で表される 1, 4-フェニレンジアミン誘導体。

【化 4】



30

(式中、 R^1 , R^2 , R^4 , R^5 は、各々独立して、水素原子、置換基を有していてもよいアシル基、または置換基を有していてもよいアルコキシカルボニル基を表し、 R^3 は、水素原子、または置換基を有していてもよいアシル基を表す。)

【請求項 6】

請求項 1 ないし 4 のいずれか 1 項に記載の高分子化合物を含む、電荷輸送材料。

【請求項 7】

請求項 1 ないし 4 のいずれか 1 項に記載の高分子化合物を含む、有機電界発光素子材料。

40

【請求項 8】

基板上に陽極、陰極、および該両極間に存在する発光層を有する有機電界発光素子において、請求項 1 ないし 4 のいずれか 1 項に記載の高分子化合物を含む層を有することを特徴とする有機電界発光素子。

【請求項 9】

請求項 8 において、該発光層と陽極との間に、前記高分子化合物と電子受容性化合物とを含有する層が設けられていることを特徴とする有機電界発光素子。

【請求項 10】

請求項 9 において、前記高分子化合物のイオン化ポテンシャルから、前記電子受容性化合物の電子親和力を引いた値が 0.7 eV 以下であることを特徴とする有機電界発光素子

50

【請求項 1 1】

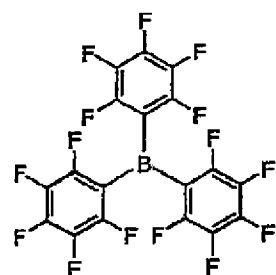
請求項 9 または 10 において、前記高分子化合物と前記電子受容性化合物とを含有する層中における、前記電子受容性化合物の含有量が、前記高分子化合物に対して 0.1 ～ 50 重量% の範囲であることを特徴とする有機電界発光素子。

【請求項 1 2】

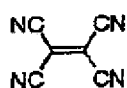
請求項 9 ないし 11 のいずれか 1 項において、前記電子受容性化合物が、下記化合物群から選ばれる少なくとも 1 種であることを特徴とする有機電界発光素子。

【化 5】

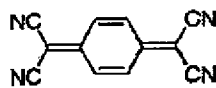
10



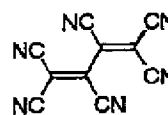
PPB



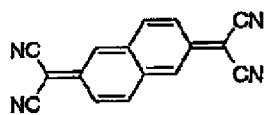
TCNE



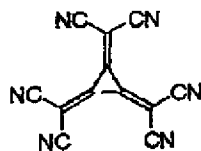
TCNQ



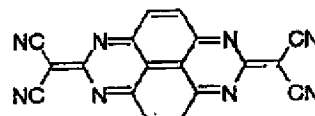
TCBD



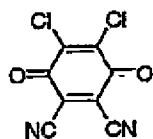
TCNP



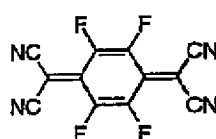
HCTMCP



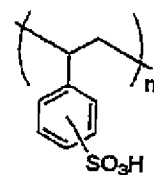
TCQQ



DDQ

[FeCp₂]PF₆

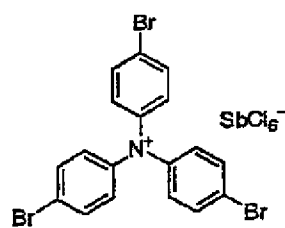
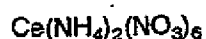
F4-TCNQ



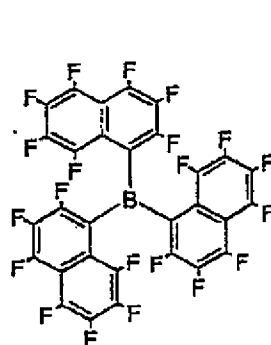
PSS

20

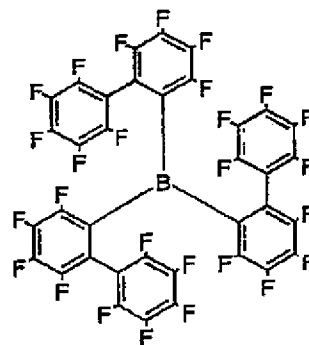
30



TBAH



PNB



PBB

40

【発明の詳細な説明】

【0001】

50

【発明の属する技術分野】

本発明は、新規高分子化合物と、この高分子化合物の合体中間体としての新規1,4-フェニレンジアミン誘導体と、この高分子化合物を用いた電荷輸送材料、有機電界発光素子材料および有機電界発光素子、即ち、有機化合物から成る発光層に電界をかけて光を放出する薄膜型デバイスに関するものである。

【0002】**【従来の技術】**

従来、薄膜型の電界発光(EL)素子としては、無機材料のII-VI族化合物半導体であるZnS、CaS、SrS等に、発光中心であるMnや希土類元素(Eu、Ce、Tb、Sm等)をドーピングしたものが一般的であるが、上記の無機材料から作製したEL素子は

10

- 1) 交流駆動が必要(50~1000Hz)、
 - 2) 駆動電圧が高い(~200V)、
 - 3) フルカラー化が困難、
 - 4) 周辺駆動回路のコストが高い、
- という問題点を有している。

【0003】

しかし、近年、上記問題点の改良のため、有機薄膜を用いたEL素子の開発が行われるようになった。特に、発光効率を高めるため、電極からのキャリア注入の効率向上を目的として電極の種類の最適化を行い、芳香族ジアミンから成る正孔輸送層と8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体から成る発光層とを設けた有機電界発光素子の開発(非特許文献1)により、従来のアントラセン等の単結晶を用いたEL素子と比較して発光効率の大幅な改善がなされ、実用特性に近づいている。

20

【0004】

上記の様な低分子材料を用いた電界発光素子の他にも、発光層の材料として、ポリ(p-フェニレンビニレン)、ポリ[2-メトキシ-5-(2-エチルヘキシルオキシ)-1,4-フェニレンビニレン]、ポリ(3-アルキルチオフェン)、ポリフルオレン等の高分子材料を用いた電界発光素子の開発や、ポリビニルカルバゾール等の高分子に低分子の発光材料と電子移動材料を混合分散した素子の開発も行われている。

30

【0005】

ところで、有機電界発光素子の最大の課題は、駆動時の寿命である。駆動時の不安定性としては、発光輝度の低下、定電流駆動時の電圧上昇、非発光部分(ダークスポット)の発生等が挙げられる。これらの不安定性の原因はいくつか存在するが、有機層の薄膜形状の劣化が支配的である。この薄膜形状の劣化は、素子駆動時の発熱による有機非晶質膜の結晶化(または凝集)等に起因すると考えられている。特に、駆動電圧の上昇については陽極と正孔輸送層のコンタクトが重要である。

【0006】

そこで、陽極と正孔輸送層のコンタクトを向上させるため両層の間に正孔注入層を設け、駆動電圧を低下させることが検討されている。正孔注入層に用いられる材料に要求される条件としては、陽極とのコンタクトがよく均一な薄膜が形成でき、熱的に安定、すなわち融点及びガラス転移温度(T_g)が高いこと、好ましくは300℃以上の融点と120℃以上のガラス転移温度を有することが要求される。さらに、陽極からの正孔注入が容易であり、かつ、注入された正孔が効率よく正孔輸送層への移動されるような、適度なイオン化ポテンシャルを有していることが要求される。また、一連の正孔注入輸送過程において、正孔移動度が大きいことが要求される。正孔注入層の材料としても種々のものが検討されており、例えばポルフィリン誘導体やフタロシアニン化合物(特許文献1)、スターバースト型芳香族トリアミン(特許文献2)、スパッタ・カーボン膜や、バナジウム酸化物、ルテニウム酸化物、モリブデン酸化物等の金属酸化物などが報告されている。

40

【0007】

しかしながら、陽極と正孔輸送層の間に正孔注入層を挿入する方法において、ポルフィリ

50

ン誘導体やフタロシアニン化合物を正孔注入層として用いた場合、これらの膜自体による光吸収のためにスペクトルが変化する、外観上着色して透明でなくなるという問題がある。

【0008】

スターバースト型芳香族トリアミンでは、適度なイオン化ポテンシャルを有し透明性がよいという利点はあるものの、ガラス転移点や融点が低いために耐熱性に難点がある。

【0009】

また、共役・非共役の各種高分子化合物を含む正孔注入層も多数提案されている。通常、有機電界発光素子の陽極として用いられるインジウム・スズ酸化物 (ITO) は、10 nm 程度の表面粗さ (Ra) を有するのに加えて、局所的に突起を有することが多く、素子作製時に短絡欠陥を生じるという問題があったが、該陽極上に、高分子化合物を含む溶液を塗布して正孔注入層を設けることにより、該欠陥の低減するという効果も得られる。

10

【0010】

このような正孔注入層材料として、例えば、ポリチエニレンビニレン、ポリチオフェン、ポリアニリン等の共役系ポリマーの使用が提案されている。しかし、これらは、溶剤への可溶性に問題があり、このため製造プロセス面での問題がある。

【0011】

また、電子受容性化合物を混合していない非共役系ポリマーを、正孔輸送層として使用することが提案されている (特許文献3、特許文献4、特許文献5、特許文献6) が、このような素子は特許文献3中17頁図4に記載されているように、6 V で 20 cd/m^2 と駆動電圧が高く、その時の発光効率も 1 cd/A と低い。

20

【0012】

更に、非共役系正孔輸送性ポリマーに電子受容性化合物を混合し、正孔注入層として使用することにより、素子の低電圧駆動が可能なが開示されている (特許文献7)。しかし、特許文献7に開示されるポリマーはガラス転移温度 T_g が低く、耐熱性に難点がある。

【0013】

上述の文献中に開示された非共役系ポリマーは、その殆どが、ビフェニレン基で結合された2個のジアリアルアミノ構造を含み、該ポリマーの正孔輸送性は、通常、このビフェニレンジアリアルアミノ構造部分に起因する。

30

【0014】

しかし、該構造の元になるモノマー成分は人体に有害であること、また該構造は電荷移動における再配向エネルギーが大きいため、正孔注入・輸送のエネルギー障壁が大きく、このため、このようなポリマーを用いた正孔注入層をもつ有機電界発光素子は、駆動寿命が十分でないと予想される。

【0015】

正孔輸送性部位として、再配向エネルギーが小さく、大きな正孔移動度をもつと予想される1, 4-フェニレンジアミン部位を有する非共役系ポリマーに、電子受容性化合物を混合し正孔注入層として用いる例が、特許文献8に記載されている。しかし、例えば具体例 (I-10) や (I-22) のように、電子供与性であるアルコキシ基やアルキル基が1, 4-フェニレンジアミン部位に直接結合している化合物はイオン化ポテンシャルが低く、正孔輸送層への電荷の移動が効率よく行われな可能性はある。具体例 (I-2) のように1, 4-フェニレンジアミン部位間の連結基におけるXが直接結合であるもの、また具体例 (I-6) のように、1, 4-フェニレンジアミン部位の一部にナフチル基を有するものは、溶剤への溶解性が低い傾向があり、該化合物の精製や、該化合物を含む層の塗布法による形成が困難になるおそれがある。

40

【0016】

1, 4-フェニレンジアミン部位を有する非共役系ポリマーを正孔輸送層として用いる例は、特許文献4にも開示されている。しかし、ここに開示されているポリマーも、電子供与性のアルキル基が1, 4-フェニレンジアミン部位に直接結合しているためイオン化ポ

50

テンシャルが低く、該化合物と電子受容性化合物を正孔注入層に併用した場合、正孔輸送層への電荷の移動が効率よく行われないと予想される。さらに、ここに開示されているポリマーはアルキル基のために耐熱性も低いと考えられる。なお、電子受容性化合物共存下では、ポリマーから電子受容性化合物への電荷移動に伴う吸収帯が低エネルギー領域に存在し、光架橋は起こらない。従って、特許文献4に開示されているような不溶化技術は、電子受容性化合物の存在下では採用できない。

【0017】

【特許文献1】

特開昭63-295695号公報

【特許文献2】

特開平4-308688号公報

【特許文献3】

特開平9-188756号公報

【特許文献4】

特開平9-255774号公報

【特許文献5】

特開平11-135262号公報

【特許文献6】

WO97/33193号公報

【特許文献7】

特開平11-283750号公報

【特許文献8】

特開2000-36390号公報

【非特許文献1】

Appl. Phys. Lett., 51巻, 913頁, 1987年

【0018】

【発明が解決しようとする課題】

このように有機電界発光素子の駆動時における電圧が高く、耐熱性を含めた安定性が低いことは、ファクシミリ、複写機、液晶ディスプレイのバックライト等の光源としては大きな問題であり、特にフルカラーフラットパネル・ディスプレイ等の表示素子としても望ましくない。

【0019】

本発明は、上記従来の問題点を解決し、低電圧、高発光効率で駆動させることができ、かつ良好な耐熱性を有し、長期間にわたって安定な発光特性を維持することができる有機電界発光素子であって、前述の陽極の表面粗さに起因する素子作製時の短絡欠陥を防止した有機電界発光素子と、この有機電界発光素子の正孔注入層材料として好適な新規高分子化合物、この高分子化合物の合成中間体としての新規1,4-フェニレンジアミン誘導体、この高分子化合物を含む電荷輸送材料および有機電界発光素子材料を提供することを目的とする。

【0020】

【課題を解決するための手段】

本発明の高分子化合物は、下記一般式(1)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする。

【0021】

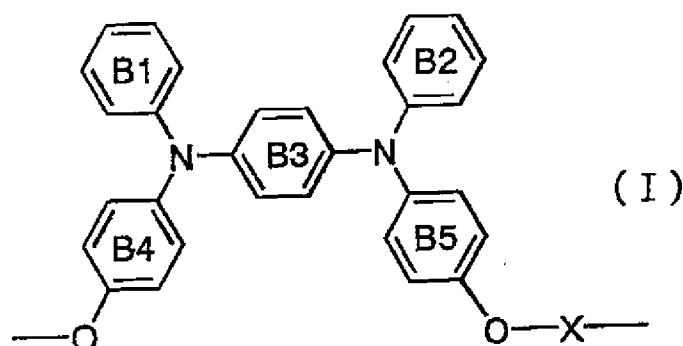
【化6】

10

20

30

40



10

(式中、環 B 1、環 B 2、環 B 4 および環 B 5 は各々独立してベンゼン環を表し、このベンゼン環は、置換基を有していてもよいアシル基、および置換基を有していてもよいアルコキシカルボニル基よりなる群から選ばれる 1 種または 2 種以上の置換基で置換されていてもよい。

環 B 3 は、置換基を有していてもよいアシル基で置換されていてもよいベンゼン環を表す。

X は、2 価の連結基を表す。)

20

【0022】

本発明の電荷輸送材料は、このような本発明の高分子化合物を含むものである。

【0023】

本発明の有機電界発光素子材料は、このような本発明の高分子化合物を含むものである。

【0024】

本発明の有機電界発光素子は、基板上に陽極、陰極、および該両極間に存在する発光層を有する有機電界発光素子において、このような本発明の高分子化合物を含む層を有することを特徴とする。

【0025】

即ち、本発明者らは、従来の問題点を解決し、高温において安定な発光特性を維持できる有機電界発光素子を提供するべく鋭意検討した結果、基板上に、陽極および陰極により挟持された発光層を有する有機電界発光素子において、陽極と発光層との間に、電子受容性化合物を含有し、かつ、高い T_g を有する高分子化合物からなる層を設けることで、上記課題を解決することができることを知見し、上記一般式 (I) で表される繰り返し単位を有する高分子化合物は、ガラス転移温度 T_g ≥ 120℃ を容易に達成することができ、このような高い T_g を有する高分子化合物と電子受容性化合物を混合して用いることで、素子の発光特性と耐熱性を同時に改善することができることを見出し、本発明を完成させた。

30

【0026】

本発明の高分子化合物は電子供与性であり、この高分子化合物に電子受容性化合物を混合することにより、電荷移動が起こり、結果としてフリーキャリアである正孔が生成し、この層の電気伝導度が高くなる。このような層を設けることで、発光層と陽極との電氣的接合が改善され、駆動電圧が低下すると同時に連続駆動時の安定性も向上する。

40

【0027】

しかも、このような高分子化合物を主成分とする層を、塗布プロセスにて陽極上に形成することにより、前述の陽極の表面粗さが緩和され、良好な表面平滑化効果が得られ、素子作製時の短絡欠陥が防止されるという効果も奏される。

【0028】

なお、本発明に係る高分子化合物と電子受容性化合物を含む層は、正孔輸送性を示す層であり、陽極と発光層との間であればどこにあっても良く、後掲の図 1～3 に示す如く、陽極上に直接設けるものに何ら限定されないが、陽極(無機材料)との電氣的接合が良く、

50

耐熱性が高いというこの層の長所を十分に生かすためには、陽極と接する位置に正孔注入層として形成するのが最も有利である。

【0029】

本発明の有機電界発光素子においては、この高分子化合物のイオン化ポテンシャルから電子受容性化合物の電子親和力を引いた値は0.7 eV以下であることが好ましく、また、これらを含む層中の電子受容性化合物の含有量は、この高分子化合物に対して0.1～50重量%の範囲であることが好ましい。

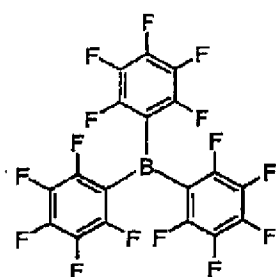
【0030】

本発明の有機電界発光素子において、電子受容性化合物は、下記化合物群から選ばれる化合物の少なくとも1種であることが好ましい。

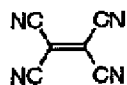
10

【0031】

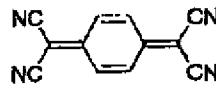
【化7】



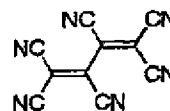
PPB



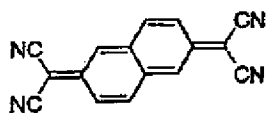
TCNE



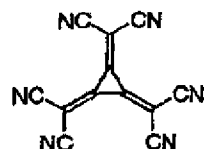
TCNQ



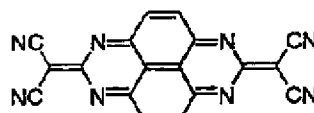
TCBD



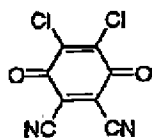
TCNP



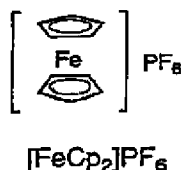
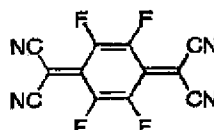
HCTMCP



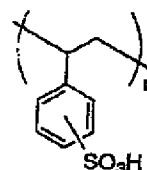
TCQQ



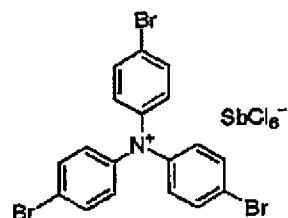
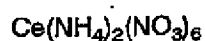
DDQ

[FeCp₂]PF₆

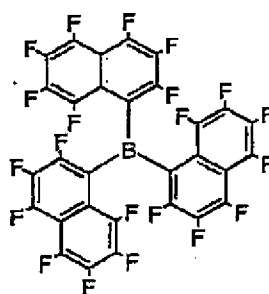
F4-TCNQ



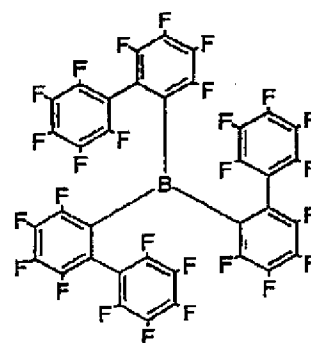
PSS



TBPAAH



PNB



PBB

【0032】

本発明の1, 4-フェニレンジアミン誘導体は、本発明の高分子化合物の合成中間体として有用な単量体であり、下記一般式(III)で表される。

【0033】

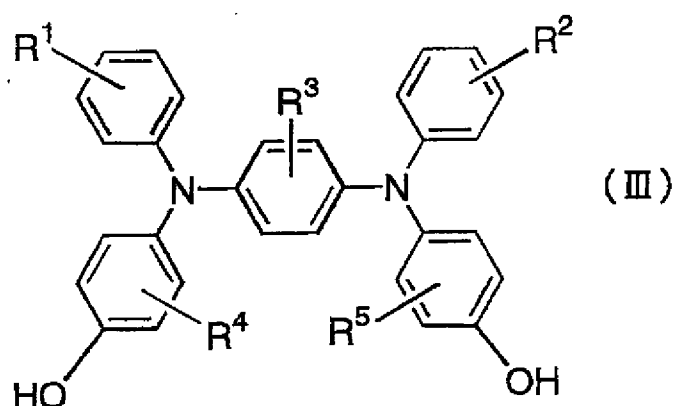
【化8】

10

20

30

40



10

(式中、 R^1 , R^2 , R^4 , R^5 は、各々独立して、水素原子、置換基を有していてもよいアシル基、または置換基を有していてもよいアルコキシカルボニル基を表し、 R^3 は、水素原子、または置換基を有していてもよいアシル基を表す。)

【0034】

【発明の実施の形態】

以下に本発明の実施の形態を詳細に説明する。

まず、本発明の高分子化合物について説明する。

20

本発明の高分子化合物は、前記一般式 (I) で表される繰り返し単位を有するものである。

【0035】

前記一般式 (I) 中の環 B 1, 環 B 2, 環 B 4 および環 B 5 は各々独立して、置換されていてもよいベンゼン環である。このベンゼン環が有しうる置換基は、置換基を有していてもよいアシル基、および置換基を有していてもよいアルコキシカルボニル基よりなる群から選ばれる 1 種または 2 種以上であり、より具体的には、置換基を有していてもよい、アセチル基等の炭素数 1 ~ 6 のアシル基；置換基を有していてもよい、メトキシカルボニル基；メトキシカルボニル基等の炭素数 2 ~ 7 のアルコキシカルボニル基である。

30

【0036】

これらの置換基が有していてもよい置換基としては、例えば、下記の置換基群 Z の 1 種または 2 種以上が挙げられる。

〔置換基群 Z〕

メチル基、エチル基等の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基；ビニル基等の炭素数 1 ~ 6 のアルケニル基；エチニル基等の炭素数 1 ~ 6 のアルキニル基；メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数 2 ~ 7 のアルコキシカルボニル基；ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基等の炭素数 1 ~ 10 のジアルキルアミノ基；ジフェニルアミノ基、ジトリルアミノ基、カルバゾリル基等のジアリールアミノ基；フェニルメチルアミノ基等のアリールアルキルアミノ基；アセチル基等の炭素数 1 ~ 6 のアシル基；フッ素原子等のハロゲン原子；トリフルオロメチル基等のハロアルキル基；フェノキシ基、ベンジルオキシ基等のアリールオキシ基；シアノ基；フェニル基、ナフチル基等の芳香族炭化水素環基

40

【0037】

環 B 1, B 2, B 4, B 5 の置換基としては、好ましくは水素原子（即ち、無置換）が挙げられる。

【0038】

1 つの繰り返し単位中に含まれる環 B 1, B 2, B 4, B 5 は各々同一であっても異なるものであってもよいが、高分子化合物の非晶質性の点からは互いに異なる方が好ましい。

【0039】

前記一般式 (I) 中の環 B 3 は、置換されていてもよいベンゼン環である。

【0040】

50

環 B 3 が有しうる置換基としては、置換基を有していてもよいアシル基が挙げられ、より具体的には、置換基を有していてもよい、アセチル基等の炭素数 1～6 のアシル基である。

【0041】

これらの置換基が有していてもよい置換基としては、前述の置換基群 Z の 1 種または 2 種以上が挙げられる。

【0042】

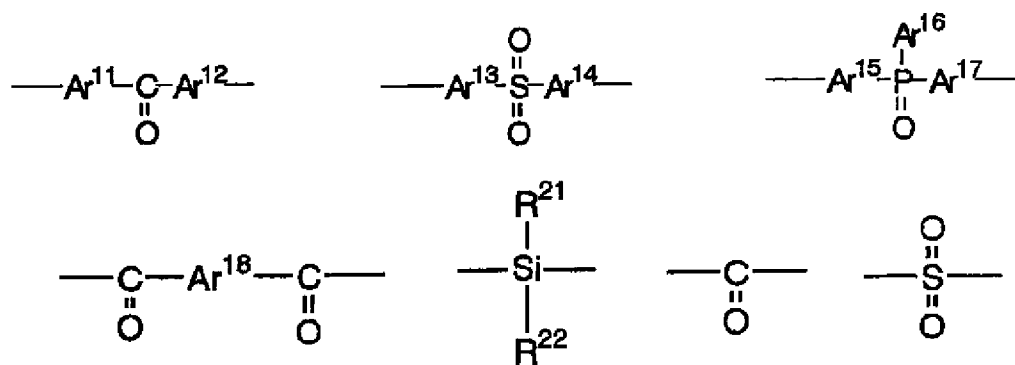
環 B 3 の置換基としては、好ましくは水素原子（即ち、無置換）が挙げられる。

【0043】

X は 2 価の連結基、好ましくは下記構造式で表される部分構造から選ばれた 2 価の連結基が挙げられる。 10

【0044】

【化 9】



20

【0045】

上記式中、 Ar^{11} ないし Ar^{18} は各々独立して、置換基を有していてもよい芳香族環、好ましくは置換基を有していてもよい、5 または 6 員環の単独または 2～3 縮合環の、芳香族炭化水素環または芳香族複素環であり、具体的には、ベンゼン環、ナフタレン環、フェナントレン環、アントラセン環、ピリジン環、キノリン環、チオフェン環、ベンゾチオフェン環、フラン環、ピロール環、インドール環、ベンゾフラン環、カルbazool 環が挙げられる。 30

【0046】

このような芳香族環が有しうる置換基としては、以下に R^{21} 、 R^{22} として例示するものが挙げられる。

【0047】

R^{21} および R^{22} は各々独立して、水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルケニル基、置換基を有していてもよいアルキニル基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基、置換基を有していてもよいアミノ基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基、または置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表し、より具体的には、水素原子、メチル基、エチル基等の炭素数 1～6 のアルキル基；置換基を有していてもよい、ビニル基等の炭素数 1～6 のアルケニル基；置換基を有していてもよい、エチニル基等の炭素数 1～6 のアルキニル基；置換基を有していてもよい、ベンジル基等のアラルキル基；置換基を有していてもよい、メトキシ基、エトキシ基等の炭素数 1～6 のアルコキシ基；置換基を有していてもよい、フェノキシ基、ベンジルオキシ基等のアリールオキシ基；置換基を有していてもよいアミノ基、例えばジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基等の炭素数 1～10 のジアルキルアミノ基；ジフェニルアミノ基、ジトリルアミノ基、カルbazool リル基等のジアリールアミノ基；フェニルメチルアミノ基等のアリールアルキルアミノ基；置換基を有していてもよい、フェニル基、ナフチル基等の芳 40 50

香族炭化水素環基；置換基を有していてもよい、チエニル基等の芳香族複素環基である。

【0048】

これらの置換基が有していてもよい置換基としては、前述の置換基群Zの1種または2種以上が挙げられる。

【0049】

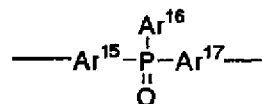
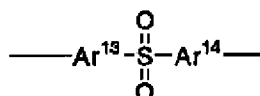
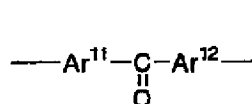
$Ar^{11} \sim Ar^{18}$ の置換基、 R^{21} 、 R^{22} として好ましいものは、水素原子（即ち、無置換）、メチル基、エチル基、メトキシ基である。

【0050】

Xは、好ましくは

【化10】

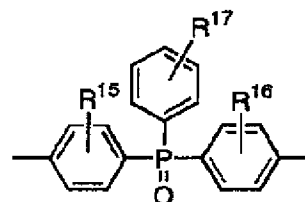
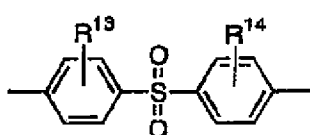
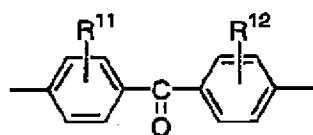
10



であり、特に、

【化11】

20



であることが好ましい。なお、 $R^{11} \sim R^{17}$ は、 $Ar^{11} \sim Ar^{18}$ が有しうる置換基として前述したものであり、好ましい基についても同様である。

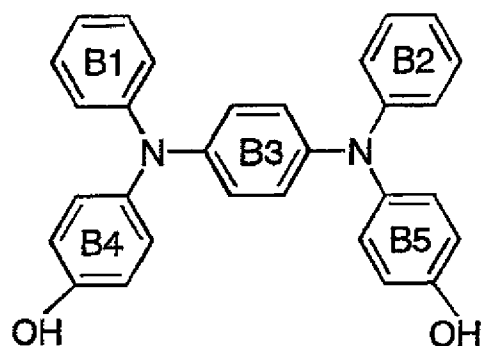
【0051】

30

このような本発明の高分子化合物は、好ましくは下記一般式（II）で表される単量体、特に好ましくは、下記一般式（III）で表される、本発明の1，4-フェニレンジアミン誘導体より合成される。

【0052】

【化12】



(II)

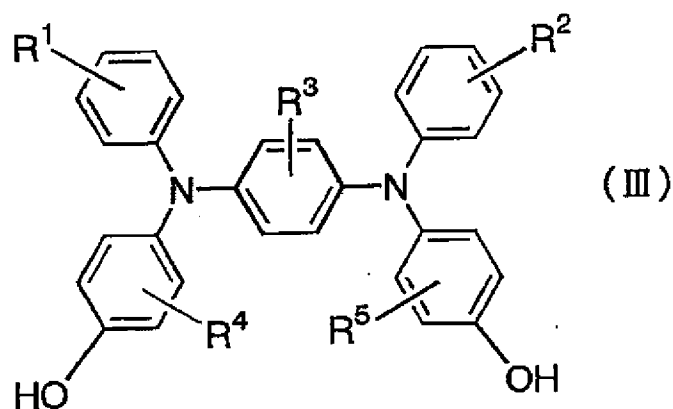
40

（上記式中、環B1ないし環B5は前記一般式（I）におけると同義である。）

【0053】

【化13】

50



10

【0054】

上記式中 R^1 , R^2 , R^4 , R^5 は各々独立して、水素原子、置換基を有していてもよいアシル基、置換基を有していてもよいアルコキシカルボニル基、より具体的には、置換基を有していてもよい、アセチル基等の炭素数1～6のアシル基；置換基を有していてもよい、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数2～7のアルコキシカルボニル基である。

20

【0055】

また、 R^3 は、水素原子、置換基を有していてもよいアシル基であり、より具体的には、置換基を有していてもよい、アセチル基等の炭素数1～6のアシル基である。

【0056】

これらの置換基が有していてもよい置換基としては、前述の置換基群Zの1種または2種以上が挙げられる。

【0057】

R^1 ないし R^5 としては、好ましくは水素原子（即ち、無置換）、フェニル基、*t*-ブチルフェニル基、スチリル基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基が挙げられる。

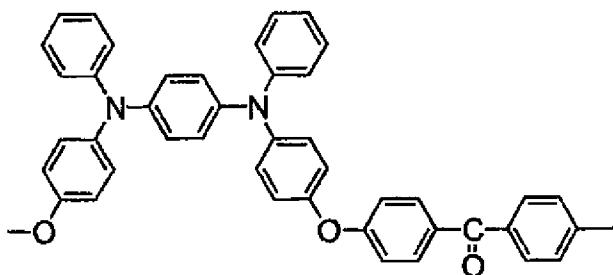
【0058】

以下に本発明の高分子化合物の繰り返し単位の好ましい具体例を示すが、本発明は何らこれらに限定されるものではない。

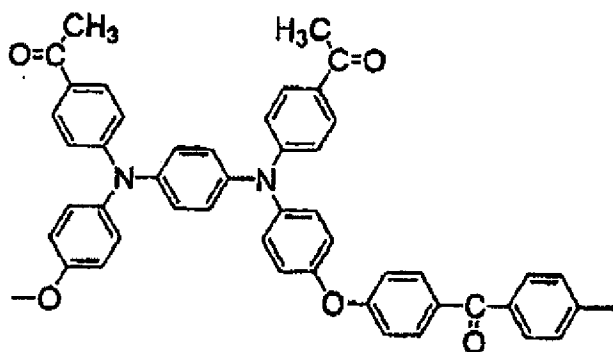
30

【0059】

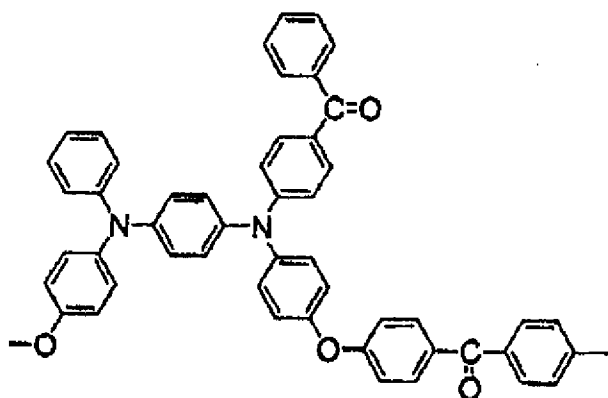
【化14】



10



20



30

【0060】

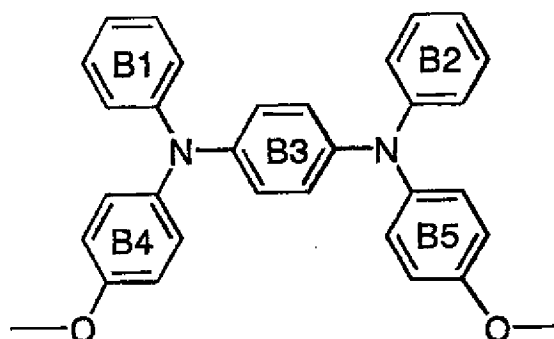
本発明の高分子化合物は、1種または2種以上の一般式（I）で表される繰り返し単位からなる高分子化合物である。

【0061】

更に、本発明の高分子化合物は、その性能を損なわない範囲で、他の種々のモノマー由来の繰り返し単位を含有していてもよい。他のモノマー由来の繰り返し単位としては、例えば前記一般式（I）で表される繰り返し単位において、

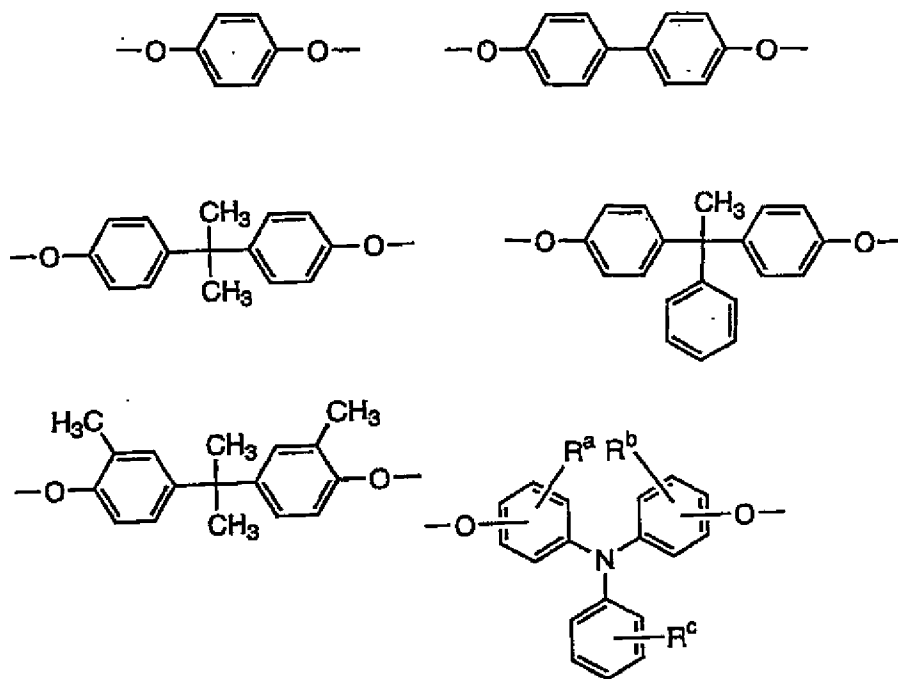
40

【化15】



10

の代わりに
【化16】



20

30

とした繰り返し単位が挙げられるが、有機電界発光素子の製造に有用な化合物としては、前記一般式(1)で表される繰り返し単位の含有量が、1分子あたり通常20モル%以上、好ましくは50モル%以上、さらに好ましくは80モル%以上のものである。

【0062】

なお、上記式中、 R^a 、 R^b 、 R^c は、各々独立して、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルケニル基、置換基を有していてもよいアルキニル基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアシル基、置換基を有していてもよいアミノ基、置換基を有していてもよいアルコキシカルボニル基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基、または置換基を有していてもよい芳香族複素環基であり、より具体的には、置換基を有していてもよい、メチル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキル基；置換基を有していてもよい、ビニル基等の炭素数1~6のアルケニル基；置換基を有していてもよい、エチニル基等の炭素数1~6のアルキニル基；置換基を有していてもよい、ペンジル基等のアラルキル基；置換基を有していてもよい、アセチル基等の炭素数1~6のアシル基；置換基を有していてもよいアミノ基、例えばジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基等の炭素数1~10のジアルキルアミノ基；ジフェニルア

40

50

ミノ基、ジトリルアミノ基、カルバゾリル基等のジアリールアミノ基；フェニルメチルアミノ基等のアリールアルキルアミノ基；置換基を有していてもよい、メトキシカルボニル基；エトキシカルボニル基等の炭素数2～7のアルコキシカルボニル基；置換基を有していてもよい、フェニル基、ナフチル基等の芳香族炭化水素環基；置換基を有していてもよい、チエニル基等の芳香族複素環基である。

【0063】

これらの置換基が有していてもよい置換基としては、前述の置換基群Zの1種または2種以上が挙げられる。

【0064】

これらの高分子化合物のうち、特に重量平均分子量が1,000～1,000,000のものが有機電界発光素子の製造に有用である。また、この高分子化合物を含む層を、塗布法により形成する場合には、架橋度により差があるが、通常は、溶解性の点から重量平均分子量が10,000～200,000程度のものが好ましい。

【0065】

本発明の高分子化合物は、例えば、先ずヒドロキシフェニル基を有する1,4-フェニレンジアミン誘導体を合成し、それと、4,4'-ジフルオロベンゾフェノン、ビス(4-フルオロフェニル)スルホン等の芳香族二フッ化物とを反応させることにより得られる。

【0066】

本発明の高分子化合物は、高い電荷輸送性を有するため、電荷輸送材料として電子写真感光体、有機電界発光素子、光電変換素子、有機太陽電池、有機整流素子等に好適に使用できる。特に正孔輸送性に優れることから、正孔輸送材料として好適である。

【0067】

また本発明の高分子化合物を用いることにより、耐熱性に優れ、長期間安定に駆動（発光）する有機電界発光素子が得られるため、有機電界発光素子材料として好適である。

【0068】

次に、図面を参照して本発明の有機電界発光素子の実施の形態を詳細に説明する。

【0069】

図1～3は本発明の有機電界発光素子の実施の形態を示す模式的な断面図であり、1は基板、2は陽極、3は正孔注入層、4は正孔輸送層、5は発光層、6は電子輸送層、7は陰極を各々表わす。

【0070】

基板1は有機電界発光素子の支持体となるものであり、石英やガラスの板、金属板や金属箔、プラスチックフィルムやシートなどが用いられる。特にガラス板や、ポリエステル、ポリメタクリレート、ポリカーボネート、ポリスルホンなどの透明な合成樹脂の板が好ましい。合成樹脂基板を使用する場合にはガスバリア性に留意する必要がある。基板のガスバリア性が低すぎると、基板を通過する外気により有機電界発光素子が劣化することがあるので好ましくない。このため、合成樹脂基板のどちらか片側もしくは両側に緻密なシリコン酸化膜等を設けてガスバリア性を確保してもよい。

【0071】

基板1上には陽極2が設けられるが、陽極2は正孔注入層3への正孔注入の役割を果たすものである。この陽極2は、通常、アルミニウム、金、銀、ニッケル、パラジウム、白金等の金属、インジウムおよび/またはスズの酸化物などの金属酸化物、ヨウ化銅などのハロゲン化金属、カーボンブラック等により構成される。陽極2の形成は通常、スパッタリング法、真空蒸着法などにより行われることが多い。また、銀などの金属微粒子、ヨウ化銅などの微粒子、カーボンブラック、導電性の金属酸化物微粒子等を適当なバインダー樹脂溶液に分散し、基板1上に塗布することにより陽極2を形成することもできる。陽極2は異なる物質で積層して形成することも可能である。陽極2の厚みは、必要とされる透明性により異なる。透明性が必要とされる場合は、可視光の透過率を、通常、60%以上、好ましくは80%以上とすることが望ましく、この場合、陽極2の厚みは、通常、1000nm以下、好ましくは500nm以下であり、下限は10nm程度、好ましくは20

n m 程度である。不透明でよい場合には陽極 2 は基板 1 と同一でもよい。また、さらには上記の陽極 2 の上に異なる導電材料を積層することも可能である。

【0072】

本発明では、図 1 の素子構造においては、陽極 2 の上に正孔注入層 3 が設けられる。この正孔注入層 3 に用いられる材料に要求される条件としては、陽極 2 からの正孔注入効率が高く、かつ、注入された正孔を効率よく輸送することができる材料であることが挙げられる。そのためには、イオン化ポテンシャルが小さく、可視光の光に対して透明性が高く、しかも正孔移動度が大きく、さらに安定性に優れ、トラップとなる不純物が製造時や使用時に発生しにくいことが要求される。上記の一般的要求以外に、車載表示用の応用を考えた場合、素子にはさらに 120℃ 以上の耐熱性が要求される。

10

【0073】

本発明の有機電界発光素子は、好ましくはこの正孔注入層 3 が前記一般式 (I) で表わされる繰り返し単位を有する本発明の高分子化合物と、電子受容性化合物とを含有するものである。

【0074】

本発明においては、通常、120℃ 以上の T_g を有する本発明の高分子化合物と電子受容性化合物を混合して用いることで、素子の発光特性と耐熱性を同時に改善することを可能とした。即ち、電子供与性の前記高分子化合物に電子受容性化合物を混合することにより、電荷移動が起こり、結果としてフリーキャリアである正孔が生成し、正孔注入層の電気導度が高くなる。このため、発光層 5 と陽極 2 との電氣的接合が、本発明による正孔注入層 3 を設けることで改善され、駆動電圧が低下すると同時に連続駆動時の安定性も向上する。また、

20

120℃ 以上の T_g を有する高分子化合物を正孔注入層 3 の母体とすることにより、素子の耐熱性も大きく改善される。

【0075】

しかも、このような本発明の高分子化合物を主成分とする正孔注入層 3 を、塗布プロセスにて陽極 2 上に形成することにより、前述の陽極 2 の表面粗さが緩和され、良好な表面平滑化効果が得られ、素子作製時の短絡欠陥が防止されるという効果も奏される。

【0076】

正孔注入層 3 に、本発明の高分子化合物と組み合わせて用いる電子受容性化合物としては、該高分子化合物との間で電荷移動を起こすものであればよいが、本発明者らが鋭意検討した結果、正孔注入層 3 に用いる本発明の高分子化合物のイオン化ポテンシャル：IP（本発明の高分子化合物）、と電子受容性化合物（アクセプタ）の電子親和力：EA（アクセプタ）の 2 つの物性値が、

30

$$IP \text{ (本発明の高分子化合物)} - EA \text{ (アクセプタ)} \leq 0.7 \text{ eV、}$$

の関係式で表される時に、本発明の目的に特に有効であることを見出した。

【0077】

このことを図 4 のエネルギー準位図を用いて説明する。一般に、イオン化ポテンシャルおよび電子親和力は真空準位を基準として決定される。イオン化ポテンシャルは物質の HOMO（最高被占分子軌道）レベルにある電子を真空準位に放出するのに必要なエネルギーで定義され、電子親和力は真空準位にある電子が物質の LUMO（最低空分子軌道）レベルに落ちて安定化するエネルギーで定義される。

40

【0078】

図 4 に示す本発明の高分子化合物の HOMO レベルのイオン化ポテンシャルと、電子受容性化合物の LUMO レベルの電子親和力の差が 0.7 eV 以下であることが好ましい。イオン化ポテンシャルは光電子分光法で直接測定されるか、電気化学的に測定した酸化電位を基準電極に対して補正しても求められる。後者の方法の場合は、例えば、飽和甘汞電極（SCE）を基準電極として用いたとき、

$$\text{イオン化ポテンシャル} = \text{酸化電位 (vs. SCE)} + 4.3 \text{ eV、}$$

で表される（“Molecular Semiconductors”, Springe

50

r-Verlag, 1985年、98頁)。電子親和力は、上述のイオン化ポテンシャルから光学的バンドギャップを差し引いて求められるか、電気化学的な還元電位から上記の式で同様に求められる。

【0079】

前記イオン化ポテンシャルと電子親和力の関係式は、酸化電位と還元電位を用いて、
(本発明の高分子化合物の酸化電位) - (アクセプタの還元電位) ≤ 0.7 V、と表現することもできる。

【0080】

なお、後述する発光層や正孔輸送層など、隣接する有機層への効率よい正孔注入の観点からは、イオン化ポテンシャルがあまり低すぎない方が更に好ましく、 $-0.1 \text{ eV} \leq \{ I$ 10
P (本発明の高分子化合物) - EA (アクセプタ) }

すなわち

$-0.1 \text{ V} \leq \{ I P \text{ (本発明の高分子化合物の酸化電位)} - E A \text{ (アクセプタの還元電位)} \}$

であることが好ましい。

【0081】

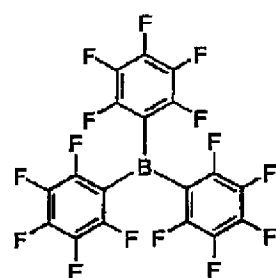
また、正孔注入層3中の電子受容性化合物の含有量は、本発明の高分子化合物に対して0.1～50重量%の範囲にあることが好ましい。さらに好ましくは、1～30重量%の濃度範囲が実用特性上望ましい。

【0082】

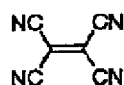
電子受容性化合物としては、前述の関係を満たすものであれば特に限定はされないが、好ましい例を、以下に省略名とともに示す。

【0083】

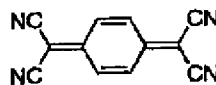
【化17】



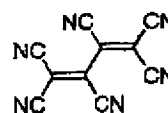
PPB



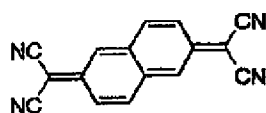
TCNE



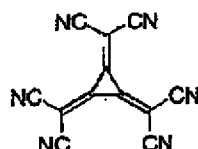
TCNQ



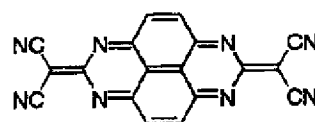
TCBD



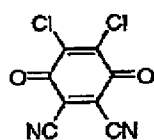
TCNP



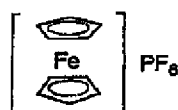
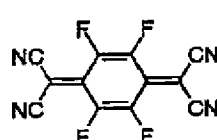
HCTMCP



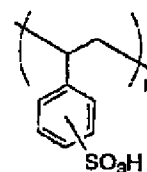
TCQQ



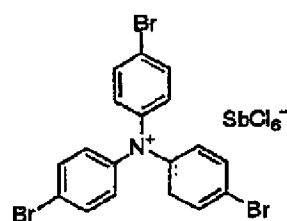
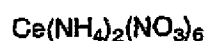
DDQ

[FeCp₂]PF₆

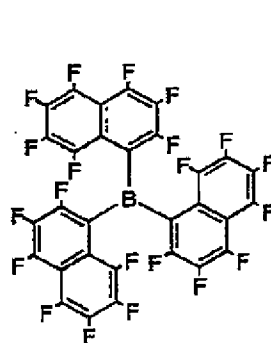
F4-TCNQ



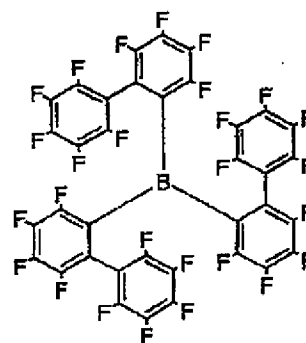
PSS



TBAH



PNB



PBB

【0084】

本発明の高分子化合物と電子受容性化合物を含有する正孔注入層3は塗布法により前記陽極2上に形成される。即ち、前記一般式(I)で表される繰り返し単位を有する本発明の高分子化合物と電子受容性化合物の所定量に、必要により正孔のトラップにならないパイプンダー樹脂や塗布性改良剤などの添加剤を添加し、適当な溶媒に溶解して塗布溶液を調製し、スピンコート法、ディップコート法やインクジェット法などの方法により陽極2上に塗布し、乾燥して正孔注入層3を形成する。

【0085】

正孔注入・輸送能の点から、正孔注入層3中の本発明の高分子化合物と電子受容性化合物との合計の含有量は20重量%以上、特に50重量%以上であることが好ましい。

【0086】

10

20

30

40

50

正孔注入層 3 の膜厚の上限は、通常 1000 nm、好ましくは 500 nm であり、下限は、通常 5 nm、好ましくは 10 nm である。

【0087】

正孔注入層 3 の上には発光層 5 が設けられる。発光層 5 は、電界を与えられた電極間において陰極 7 からの注入された電子と正孔注入層 3 から輸送された正孔を効率よく再結合し、かつ、再結合により効率よく発光する材料から形成される。

【0088】

このような条件を満たす材料としては、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体などの金属錯体（特開昭 59-194393 号公報）、10-ヒドロキシベンゾ[h]キノリンの金属錯体（特開平 6-322362 号公報）、ビスチリルベンゼン誘導体（特開平 1-245087 号公報、同 2-222484 号公報）、ビスチリルアリーレン誘導体（特開平 2-247278 号公報）、（2-ヒドロキシフェニル）ベンゾチアゾールの金属錯体（特開平 8-315983 号公報）、シロール誘導体等が挙げられる。これらの発光層材料は、通常は真空蒸着法により正孔注入層 3 上に積層される。

【0089】

素子の発光効率を向上させるとともに発光色を変える目的で、例えば、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体をホスト材料として、クマリン等のレーザ用蛍光色素をドーピングすること（J. Appl. Phys., 65 巻, 3610 頁, 1989 年）等が行われている。

【0090】

素子の駆動寿命を改善する目的においても、前記発光層材料をホスト材料として、蛍光色素をドーピングすることは有効である。例えば、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体などの金属錯体をホスト材料として、ルブレンに代表されるナフタセン誘導体（特開平 4-335087 号公報）、キナクリドン誘導体（特開平 5-70773 号公報）、ペリレン等の縮合多環芳香族炭化水素環（特開平 5-198377 号公報）を、ホスト材料に対して 0.1~10 重量%ドーピングすることにより、素子の発光特性、特に駆動安定性を大きく向上させることができる。発光層のホスト材料に上記ナフタセン誘導体、キナクリドン誘導体、ペリレン等の蛍光色素をドーピングする方法としては、共蒸着による方法と蒸着源を予め所定の濃度で混合しておく方法がある。

【0091】

高分子系の発光層材料としては、先に挙げたポリ(p-フェニレンビニレン)、ポリ[2-メトキシ-5-(2-エチルヘキシルオキシ)-1,4-フェニレンビニレン]、ポリ(3-アルキルチオフェン)等の高分子材料や、ポリビニルカルバゾール等の高分子に発光材料と電子移動材料を混合した系等が挙げられる。これらの材料は正孔注入層 3 と同様にスピンコートやディップコート等の方法により正孔注入層 3 上に塗布して薄膜化される。

【0092】

発光層 5 の膜厚の上限は、通常 200 nm、好ましくは 100 nm であり、下限は通常 10 nm、好ましくは 30 nm である。

【0093】

素子の発光特性を向上させるために、図 2 に示す様に、正孔輸送層 4 を正孔注入層 3 と発光層 5 との間に設けたり、さらには、図 3 に示す様に電子輸送層 6 を発光層 5 と陰極 7 の間に設けるなどして機能分離型の有機電解発光素子とすることが行われる。

【0094】

図 2 および図 3 の機能分離型素子において、正孔輸送層 4 の材料としては、正孔注入層 3 からの正孔注入効率が高く、かつ、注入された正孔を効率よく輸送することができる材料であることが必要である。そのためには、イオン化ポテンシャルが小さく、しかも正孔移動度が大きく、さらに安定性に優れ、トラップとなる不純物が製造時や使用時に発生しにくいことが要求される。また、発光層 5 と直接接する層であるために、発光を消光する物質が含まれていないことが望ましい。

10

20

30

40

50

【0095】

このような正孔輸送材料としては、例えば、4, 4'-ビス[N-(9-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニルで代表される2個以上の3級アミンを含み2個以上の縮合芳香族炭化水素環が窒素原子に置換した芳香族ジアミン(特開平5-234681号公報)、4, 4', 4"-トリス(1-ナフチルフェニルアミノ)トリフェニルアミン等のスターバースト構造を有する芳香族アミン化合物(J. Lumin., 72-74巻、985頁、1997年)、トリフェニルアミンの四量体から成る芳香族アミン化合物(Chem. Commun., 2175頁、1996年)、2, 2', 7, 7'-テトラキス-(ジフェニルアミノ)-9, 9'-スピロピフルオレン等のスピロ化合物(Synth. Metals, 91巻、209頁、1997年)等が挙げられる。これらの化合物は、単独で用いてもよいし、必要に応じて2種以上を混合して用いてもよい。

10

【0096】

上記の化合物以外に、正孔輸送層4の材料として、ポリビニルカルbazoon、ポリビニルトリフェニルアミン(特開平7-53953号公報)、テトラフェニルベンジジンを含むポリアリーレンエーテルサルホン(Polym. Adv. Tech., 7巻、33頁、1996年)等の高分子材料が挙げられる。

【0097】

正孔輸送層4は、上記の正孔輸送材料を塗布法あるいは真空蒸着法により前記正孔注入層3上に積層することにより形成される。

【0098】

塗布法の場合は、正孔輸送材料の1種または2種以上と、必要により正孔のトラップにならないバインダー樹脂や塗布性改良剤などの添加剤とを添加し、適当な溶媒に溶解して塗布溶液を調製し、スピンコート法などの方法により陽極2上に塗布し、乾燥して正孔輸送層4を形成する。この場合、バインダー樹脂としては、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル等を用いることができる。バインダー樹脂は添加量が多いと正孔移動度を低下させるので、少ない方が望ましく、通常、正孔輸送層4中の割合で50重量%以下が好ましい。

20

【0099】

真空蒸着法の場合には、正孔輸送材料を真空容器内に設置されたルツボに入れ、真空容器内を適当な真空ポンプで 10^{-4} Pa程度にまで排気した後、ルツボを加熱して、正孔輸送材料を蒸発させ、ルツボと向き合っていた置かれた、正孔注入層3が形成された基板1上に正孔輸送層4を形成させる。

30

【0100】

正孔輸送層4の膜厚の上限は、通常300 nm、好ましくは100 nmであり、下限は通常10 nm、好ましくは30 nmである。このように薄い膜を一様に形成するためには、一般に真空蒸着法がよく用いられる。

【0101】

有機電界発光素子の発光効率をさらに向上させる方法として、図3に示すように発光層4の上にさらに電子輸送層6を積層することもできる。この電子輸送層6に用いられる化合物には、陰極7からの電子注入が容易で、電子の輸送能力がさらに大きいことが要求される。このような電子輸送材料としては、既に発光層材料として挙げた8-ヒドロキシキノリンのアルミ錯体、オキサジアゾール誘導体(Appl. Phys. Lett., 55巻、1489頁、1989年)やそれらをポリメタクリル酸メチル(PMMA)等の樹脂に分散した系、フェナントロリン誘導体(特開平5-331459号公報)、2-トープチル-9, 10-N, N'-ジシアノアントラキノンジイミン、n型水素化非晶質炭化シリコン、n型硫化亜鉛、n型セレン化亜鉛等が挙げられる。

40

【0102】

電子輸送層6の膜厚の上限は、通常200 nm、好ましくは100 nmであり、下限は通常5 nm、好ましくは10 nmである。

【0103】

50

陰極 7 は、発光層 5 に電子を注入する役割を果たす。陰極 7 の形成材料としては、前記陽極 2 に使用される材料を用いることが可能であるが、効率よく電子注入を行なうには、仕事関数の低い金属が好ましく、スズ、マグネシウム、インジウム、カルシウム、アルミニウム、銀等の適当な金属またはそれらの合金が用いられる。具体例としては、マグネシウム-銀合金、マグネシウム-インジウム合金、アルミニウム-リチウム合金等の低仕事関数合金電極が挙げられる。さらに、陰極 7 と発光層 5 または電子輸送層 6 の界面に LiF 、 MgF_2 、 Li_2O 等の極薄絶縁膜 (0.1~5 nm) を挿入することも、素子の効率を向上させる有効な方法である (Appl. Phys. Lett., 70 巻, 152 頁, 1997 年; 特開平 10-74586 号公報; IEEE Trans. Electron. Devices, 44 巻, 1245 頁, 1997 年)。

10

【0104】

陰極 7 の膜厚は通常、陽極 2 と同様である。低仕事関数金属から成る陰極を保護する目的で、この上にさらに、仕事関数が高く大気に対して安定な金属層を積層することは素子の安定性を増す。この目的のために、アルミニウム、銀、銅、ニッケル、クロム、金、白金等の金属が使われる。

【0105】

図 1~3 は、本発明で採用される素子構造の一例であって、本発明は何ら図示のものに限定されるものではない。例えば、図 1 とは逆の構造、即ち、基板上に陰極 7、発光層 5、正孔注入層 3、陽極 2 の順に積層することも可能であり、既述したように少なくとも一方が透明性の高い 2 枚の基板の間に本発明の有機電界発光素子を設けることも可能である。同様に、図 2 および図 3 に示した前記各層構成とは逆の構造に積層することも可能である。

20

【0106】

更に、本発明の有機電界発光素子の性能を損なわない限り、図 1、図 2 および図 3 に示した各層間に任意の層を有していてもよい。

【0107】

このような本発明の有機電界発光素子は、単一の素子、アレイ状に配置された構造からなる素子、陽極と陰極が X-Y マトリックス状に配置された構造のいずれにも適用することができる。

30

【0108】

【実施例】

次に、本発明を合成例、実験例、実施例および比較例によって更に具体的に説明するが、本発明はその要旨を超えない限り、以下の実施例の記載に限定されるものではない。

【0109】

まず、一般式 (I) で表される繰り返し単位を有する高分子化合物の原料となる、本発明の 1, 4-フェニレンジアミン誘導体の合成例を示す。

【0110】

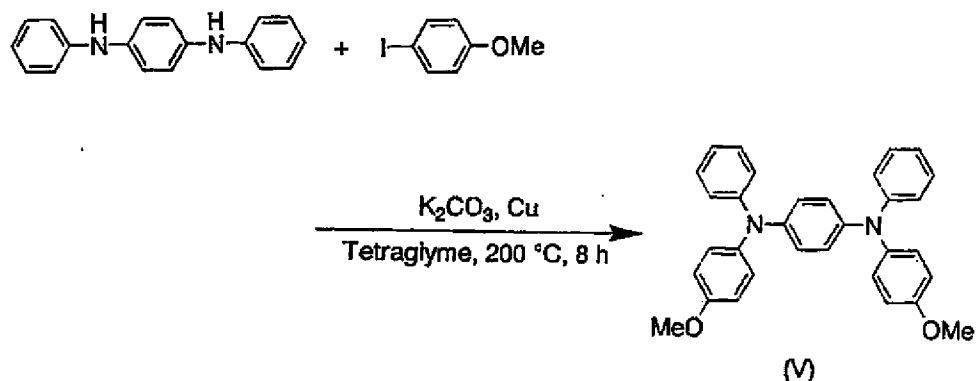
合成例 1

(1-1) N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス(4-メトキシフェニル)-1, 4-フェニレンジアミン (BMPP) の合成

40

【0111】

【化 18】



10

【0112】

N, N'-ジフェニル-1, 4-フェニレンジアミン (77.0ミリモル) と4-ヨードアニソール (231ミリモル) とをテトラグライム150ミリリットルに溶かし、銅粉末 (154ミリモル) および炭酸カリウム (112ミリモル) の存在下、窒素雰囲気中200℃で8時間反応を行った。その結果、式 (V) で示されるBMPP (34.8g、収率96%) を得た。

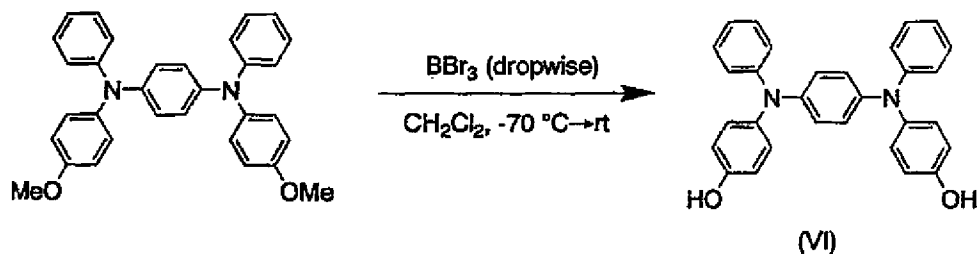
【0113】

(1-2) N, N'-ジフェニル-N, N'-(4-ヒドロキシフェニル)-1, 4-フェニレンジアミン (BHPP) の合成

20

【0114】

【化19】



30

【0115】

BMPP (50.0ミリモル) を360ミリリットルの塩化メチレンに溶かし、窒素雰囲気下、ドライアイス-エタノールバスで系内を-65℃以下に冷やし、これに三臭化ほう素 (100ミリモル) の塩化メチレン溶液 (100ミリリットル) を滴下した。滴下終了後、冷媒バスを外し2時間攪拌した後、酢酸エチルで抽出し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによって精製した。その結果、式 (VI) で示されるBHPP (16.2g、収率73%) を得た。

【0116】

以下に、BHPPの¹H-NMR (DMSO-d₆) データを示す。

9.361 (2H, s)

7.189 (4H, dd, J=6.7, 6.6)

6.936 (4H, dd, J=5.7, 1.7)

6.875 (4H, s)

6.865-6.837 (6H, m)

6.751 (4H, dd, J=5.7, 1.7)

【0117】

次に本発明の高分子化合物の合成例を示す。

【0118】

40

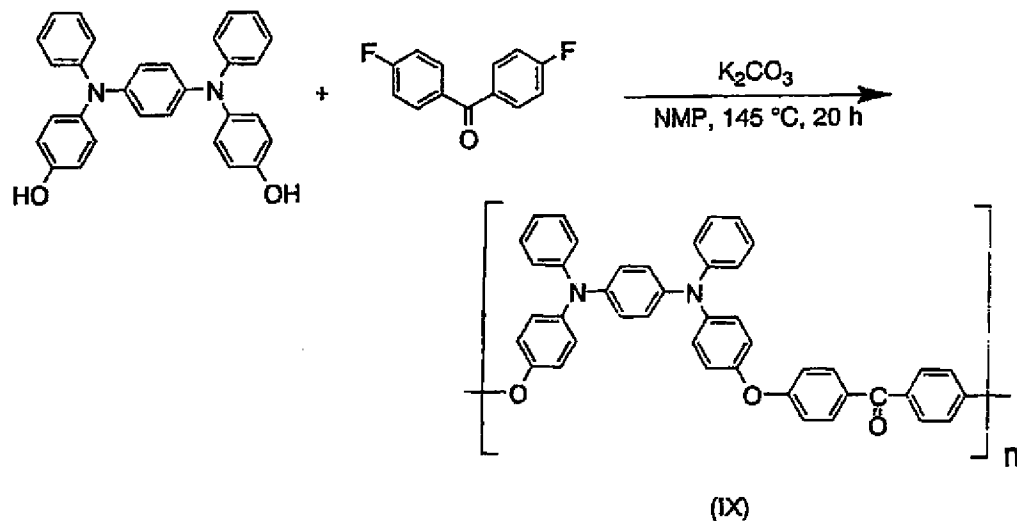
50

合成例 2

1, 4-フェニレンジアミン含有高分子化合物 (PPPEK) の合成

【0119】

【化20】



10

20

【0120】

BHPP (20.0ミリモル) と 4, 4'-ジフルオロベンゾフェノン (20.0ミリモル) とを 200ミリリットルの 1-メチル 2-ピロリジノン (NMP) に溶かし、炭酸カリウム (120ミリモル) の存在下、窒素雰囲気中 145℃ で 20 時間、縮合反応させた。放冷後、酢酸 10ミリリットルを反応系に加え、メタノール中に放出し、得られたポリマーを水洗いし、無機塩を除いた。60℃ で減圧乾燥させた後、ポリマーを 300ミリリットルのクロロホルムに溶かし、メタノールに放出し再沈殿させた。最後に、400ミリリットルのアセトンで懸洗することにより、低分子量成分を除き、繰り返し単位 (IX) からなるホモポリマー PPPEK (収量 11.8g、収率 95%) を得た。

30

【0121】

このポリマーの T_g は 183℃、窒素雰囲気下の熱分解温度は 550℃ 以上であり、重量平均分子量 (M_w) は 46,700、数平均分子量 (M_n) 7,520 であった。なお、分子量はクロロホルム中で GPC 測定により、ポリスチレンを標準試料として求めた。

【0122】

次に、合成例 2 で得られた 1, 4-フェニレンジアミン含有高分子化合物のイオン化ポテンシャルを測定する実験例を示す。

【0123】

実験例 1

ガラス基板をアセトンで超音波洗浄、純水で水洗した後、イソプロピルアルコールで超音波洗浄し、次いで乾燥窒素で乾燥後、紫外線/オゾン洗浄を行った後、合成例 2 にて得られた 1, 4-フェニレンジアミン含有高分子化合物 (PPPEK) を下記の条件で、上記ガラス基板上にスピンコートした：

40

溶媒 : シクロヘキサノン
 塗布液濃度 : 5.0 mg/ml
 スピナ回転数 : 1500 rpm
 スピナ回転時間 : 30 秒
 乾燥条件 : 120℃ で 2 時間

【0124】

上記のスピンコートにより 20nm の膜厚の均一な薄膜が形成された。この薄膜試料のイ

50

オン化ポテンシャルを理研計器（株）製の紫外線電子分析装置（AC-1）を用いて測定したところ、5.18 eVの値を示した。

【0125】

いくつかの電子受容性化合物について、還元電位が報告されているものについての電子親和力と、上記1, 4-フェニレンジアミン含有高分子化合物（PPPEK）のイオン化ポテンシャルとの差を表1に示す。

【0126】

【表1】

電子受容性化合物	還元電位 [V vs. SCE]	電子親和力 [eV]	イオン化ポテンシャル － 電子親和力 [eV]
C ₆₀	-0.44	3.86	1.32
p-クロラニル	-0.01	4.29	0.89
TCNQ	0.19	4.49	0.69
DDQ	0.51	4.81	0.47
TBPAH	1.06	5.36	-0.18

10

20

【0127】

以下に、合成された1, 4-フェニレンジアミン含有高分子化合物を用いた有機電界発光素子の性能評価を行う実施例と比較例を挙げる。

【0128】

実施例1

30

図3に示す構造を有する有機電界発光素子を以下の方法で作製した。

【0129】

ガラス基板1上にインジウム・スズ酸化物（ITO）透明導電膜を120 nm堆積したもの（ジオマテック社製；電子ビーム成膜品；シート抵抗15 Ω/sq）を通常のフォトリソグラフィ技術と塩酸エッチングを用いて2 mm幅のストライプにパターニングして陽極2を形成した。パターン形成したITO基板を、アセトンによる超音波洗浄、純水による水洗、イソプロピルアルコールによる超音波洗浄の順で洗浄後、窒素ブローで乾燥させ、最後に紫外線/オゾン洗浄を行った。

【0130】

このITOガラス基板上に、1, 4-フェニレンジアミン含有高分子化合物（PPPEK）とPPBの混合物を下記の条件でスピンコートした。

40

【スピンコート条件】

溶媒 : シクロヘキサノン
PPPEK : 5.0 mg/ml
PPB : 0.5 mg/ml
スピナ回転数 : 1500 rpm
スピナ回転時間 : 30 秒
乾燥条件 : 120℃で2時間

【0131】

上記のスピンコートにより20 nmの膜厚の均一な薄膜形状を有する正孔注入層3を形成

50

した。

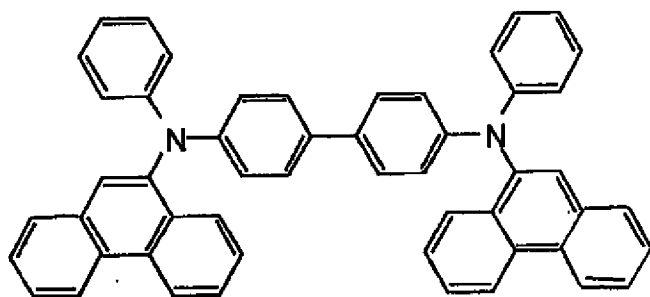
【0132】

次に、上記正孔注入層3を塗布成膜した基板を真空蒸着装置内に設置した。この装置の粗排気を油回転ポンプにより行った後、装置内の真空度が 2×10^{-6} Torr (約 2.7×10^{-4} Pa) 以下になるまで液体窒素トラップを備えた油拡散ポンプを用いて排気した。この装置内に配置されたセラミックるつぼに入れた以下に示す芳香族ジアミン化合物：4,4'-ビス[N-(9-フェナンチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニルを加熱して蒸着を行った。蒸着時の真空度は 1.3×10^{-6} Torr (約 1.7×10^{-4} Pa)、蒸着速度は0.3 nm/秒で、膜厚20 nmの膜を正孔注入層3の上に積層して正孔輸送層4を完成させた。

10

【0133】

【化21】



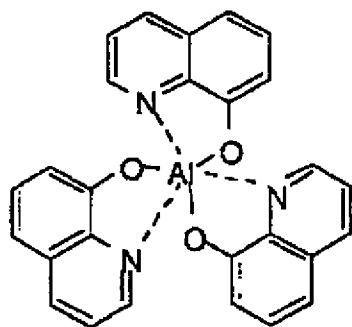
20

【0134】

引続き、発光層5の材料として、以下の構造式に示すアルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体：Al(C₉H₆NO)₃、とルブレンとを同時に蒸着した。

【0135】

【化22】



30

【0136】

アルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体に対するルブレンの割合は2.5 vol. % になるようにした。この時のアルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体のるつぼ温度は275~285℃の範囲で制御し、蒸着時の真空度は 1.2×10^{-6} Torr (約 1.6×10^{-4} Pa)、蒸着速度は0.4 nm/秒であった。またルブレンのるつぼ温度は240~250℃の範囲で制御し、蒸着速度は0.01 nm/秒であった。このように蒸着された発光層5の膜厚は30 nmであった。

40

【0137】

続いて、電子輸送層6としてアルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体：Al(C₉H₆NO)₃を正孔輸送層4と同様に蒸着を行った。この時のアルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体のるつぼ温度は275~285℃の範囲で制御し、蒸着時の真空度は 1.1×10^{-6} Torr (約 1.5×10^{-4} Pa)、蒸着速度は0.4 nm/秒で、

50

蒸着された電子輸送層 6 の膜厚は 45 nm であった。

【0138】

なお、上記の正孔輸送層 4 および発光層 5、電子輸送層 6 を真空蒸着する時の基板温度は室温に保持した。

【0139】

ここで、電子輸送層 6 までの蒸着を行った素子を一度前記真空蒸着装置内より大気中に取り出して、陰極蒸着用のマスクとして 2 mm 幅のストライプ状シャドーマスクを、陽極 2 の ITO ストライプと直交するように素子に密着させた後、別の真空蒸着装置内に設置して、各有機層形成時と同様にして装置内の真空度が 2×10^{-6} Torr (約 2.7×10^{-4} Pa) 以下になるまで排気した。

10

【0140】

その後、陰極 7 として、まず、フッ化リチウム (LiF) をモリブデンボートを用いて、蒸着速度 0.02 nm/秒、真空度 7.0×10^{-6} Torr (約 9.3×10^{-4} Pa) で、 0.5 nm の膜厚となるように電子輸送層 6 の上に成膜した。次に、アルミニウムを同様にモリブデンボートにより加熱して、蒸着速度 0.5 nm/秒、真空度 1×10^{-5} Torr (約 1.3×10^{-3} Pa) で、膜厚 80 nm のアルミニウム層を形成して、陰極 7 を完成させた。以上の 2 層型陰極 7 の蒸着時の基板温度は室温に保持した。

【0141】

以上の様にして、 $2 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$ のサイズの発光面積部分を有する有機電界発光素子が得られた。この素子の発光特性を表 2 に示す。表 2 において、発光輝度は 250 mA/cm^2 の電流密度での値、発光効率 は 100 cd/m^2 での値、輝度/電流は輝度-電流密度特性の傾きを、電圧は

20

100 cd/m^2 での値を各々示す。

【0142】

表 2 より、駆動電圧の低い、高輝度かつ高発光効率で発光する素子が得られたことが明らかである。

【0143】

【表 2】

	発光輝度 [cd/m ²] @250mA/cm ²	発光効率 [lm/W] @100cd/cm ²	輝度/電流 [cd/A]	電圧 [V] @100cd/cm ²
実施例1	17570	6.2	8.7	4.5

30

【0144】

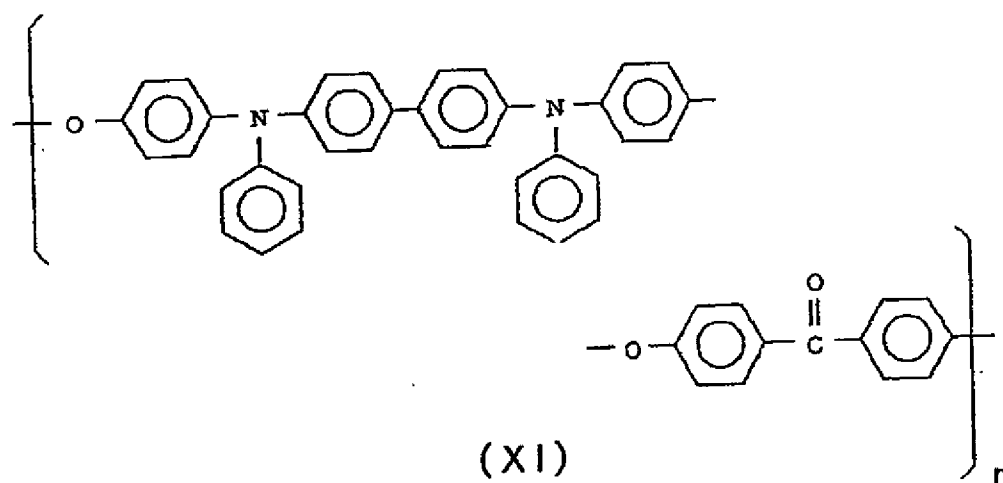
比較例 1

1, 4-フェニレンジアミン含有高分子化合物 (PPPEK) の代わりに、特開平 9-188756 号公報中 9 頁に記載されている、下記の繰り返し単位 (XI) のみからなるホモポリマー (重量平均分子量 (Mw) 74700, 数平均分子量 (Mn) 15000) を用い、正孔注入層 3 を形成する際の、ITO ガラス基板上へのスピンコート の条件を以下の通りとした他は、実施例 1 と同様に素子を作成した。

40

【0145】

【化 23】



10

【0146】

[スピノコート条件]

溶媒 : シクロヘキサノン
 高分子化合物 (X1) : 5.0 mg/ml
 PPB : 0.5 mg/ml
 スピナ回転数 : 1500 rpm
 スピナ回転時間 : 30秒
 乾燥条件 : 120℃で2時間

20

【0147】

比較例1にて得られた素子と、実施例1にて得られた素子について、駆動寿命を評価した。駆動寿命は、初期輝度300 cd/m²、85℃で駆動した時の輝度半減時間で表した。結果を表3に示す。

【0148】

【表3】

30

	駆動寿命 [時間] @ 85℃
実施例1	700
比較例1	530

40

【0149】

表3より、本発明の有機電界発光素子は、駆動寿命が長く、耐熱性に優れることが示された。

【0150】

以上の結果から明らかなように、塗布プロセスに有利な、本発明の高分子化合物と電子受容性化合物を含有する正孔注入層を形成することにより、低電圧で駆動可能かつ耐熱性の向上した素子を得ることができる。

【0151】

【発明の効果】

50

以上詳述した通り、本発明の新規高分子化合物、好ましくは本発明の新規 1, 4-フェニレンジアミン誘導体より合成される高分子化合物を用いることにより、低電圧、高発光効率で駆動させることができ、かつ良好な耐熱性を有し、長期間にわたって安定な発光特性を維持することができる有機電界発光素子であって、陽極の表面粗さに起因する素子作製時の短絡欠陥を防止した有機電界発光素子が提供される。

【0152】

従って、本発明による有機電界発光素子は、フラットパネル・ディスプレイ（例えばOAコンピュータ用や壁掛けテレビ）や面発光体としての特徴を生かした光源（例えば、複写機の光源、液晶ディスプレイや計器類のバックライト光源）、表示板、標識灯への応用が考えられ、特に、高耐熱性が要求される車載用表示素子としては、その技術的価値は大きいものである。

10

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機電界発光素子の実施の形態の一例を示す模式的な断面図である。

【図2】本発明の有機電界発光素子の実施の形態の他の例を示す模式的な断面図である。

【図3】本発明の有機電界発光素子の実施の形態の別の例を示す模式的な断面図である。

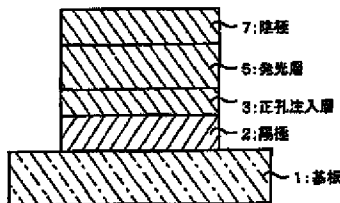
【図4】本発明の高分子化合物のイオン化ポテンシャルと電子受容性化合物の電子親和力との関係を示したエネルギー準位図である。

【符号の説明】

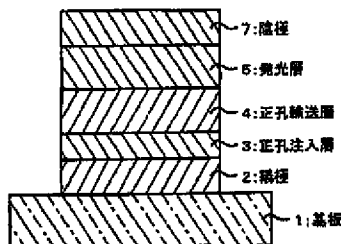
- 1 基板
- 2 陽極
- 3 正孔注入層
- 4 正孔輸送層
- 5 発光層
- 6 電子輸送層
- 7 陰極

20

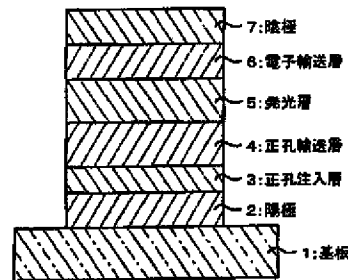
【図1】



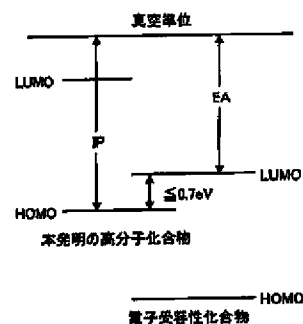
【図2】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

(51)Int. Cl.⁷

F I

テーマコード (参考)

H 0 5 B 33/22

H 0 5 B 33/14

A

H 0 5 B 33/22

D

Fターム(参考) 4H006 AA01 AA03 AB46 BJ50 BN30 BU46

4J005 AA24 BA00

4J031 BA08 BA12 BA15 BA18 BB01 BB02 BB03 BB04 BB05 BB06

BD23